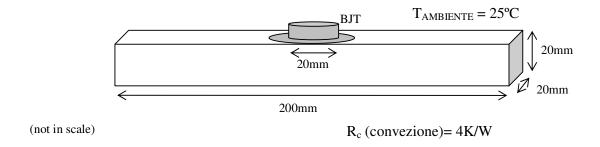
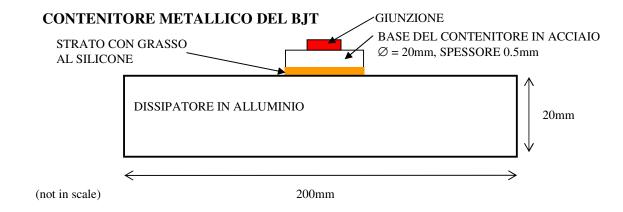


SIMULAZIONE DELLA RISPOSTA AL TRANSITORIO DI UN CIRCUITO TERMICO CON BJT DI POTENZA E DISSIPATORE

- 1. Considerare un gradino di potenza $P_0 = 20$ W applicato al tempo t = 0.
- 2. Considerare il seguente sistema termico.





PARAMETRI TERMICI

MATERIALE	DENSITA'	CALORE SPECIFICO	CONDUCIBILITA'
	ρ [kg/m³]	C _S [J/Kkg]	TERMICA
			σ_{θ} [W/mK]
ALLUMINIO	2700	900	205
ACCIAIO (347)	7860	473	18

RESISTENZA TERMICA (R_{θ}) [K/W]

$$R_{\theta} = \frac{d}{S \cdot \sigma_{\theta}}$$

dove:

- d [m] spessore
- $S[m^2]$ superficie
- σ_{θ} [W/mK]

CAPACITA' TERMICA (C₀) [J/kg]

$$C_{\theta} = \rho \cdot C_{s} \cdot V$$

dove:

- $V[m^3]$ volume
- C_S [J/Kkg]
- ρ [kg/m³]

CALCOLO DEL CIRCUITO TERMICO EQUIVALENTE

GIUNZIONE DEL BJT

$$R_{JF} = 0.7 K/W$$

$$C_{J} = 0.1 J/K$$

• FLANGIA CONTENITORE

$$R_{FH} = \frac{1}{\sigma_{H(ACC)}} \cdot \frac{d}{S} = \frac{1}{18} \cdot \frac{0.5 \times 10^{-3}}{\pi \cdot 1 \times 10^{-4}} \approx 0.09 \, K/W$$

$$C_F = \rho \cdot V \cdot C_{S(ACC)} = 7860 \pi \times 10^{-4} \cdot 0.5 \times 10^{-3} \cdot 473 = 0.58 \, J/K$$

• STRATO DI GRASSO AL SILICONE

$$R_S = 0.4K/W$$

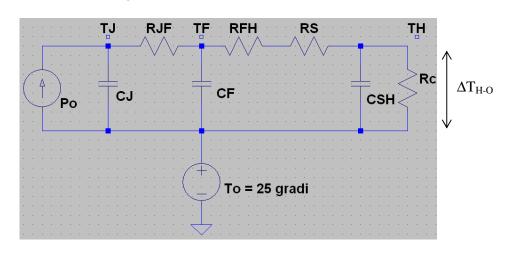
 C_S trascurabile essendo lo spessore << 1mm

DISSIPATORE DI ALLUMINIO

$$R_{SH} = \frac{1}{\sigma_{H(ALL)}} \cdot \frac{d}{S} = \frac{1}{205} \cdot \frac{2 \times 10^{-2}}{2 \cdot 20 \times 10^{-4}} = 0.024 K/W \quad \text{(trascurabile rispetto a Rc)}$$

$$C_{SH} = \rho \cdot V \cdot C_{S(ALL)} = 2700 \cdot 2 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 900 = 194 J/K$$

• CIRCUITO ELETTRICO EQUIVALENTE

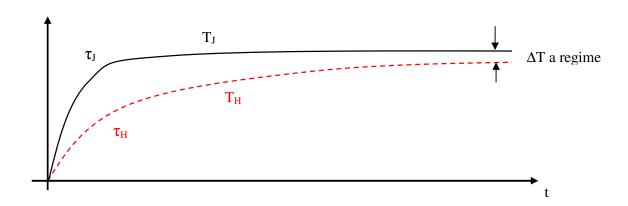




• Tramite il simulatore P-SPICE, calcolare l'andamento temporale delle temperature sulla giunzione (T_J) , sul contenitore (T_F) e sul dissipatore (T_H) , considerando una temperatura ambiente $T_0 = 25^{\circ}\text{C}$, eccitazione a gradino con ampiezza 20W e resistenza termica di convezione del dissipatore pari a $R_C = 4 \text{K/W}$.

• OSSERVAZIONE:

Per il progetto di un sistema di controllo della temperatura della giunzione è necessario poter misurare la temperatura del dissipatore mediante un sensore di tipo metallico resistivo o al silicio. Si deve considerare quindi non solo la differenza di temperatura a regime ma anche il ritardo fra l'evoluzione di T_J e T_S .



Note: